マルチフィラメント型イットリウム系超電導線材

国立大学法人 力	九州大学	木	須	隆	暢 ¹ ・:	岩	熊	成	卓 ²	
新規事業推進セ	:ンター	栗	原		駿 ³ ・	大	保	雅	載 ⁴	
先端技術総合	研究所	藤	田	真	司5・	中	村	直	識 ⁵ ・五 十 嵐 光 則 ⁵ ・飯 島 康 裕 ⁶ ・直 江 邦 法	浩

Multi-filamentary Y-based Coated Conductors

C. Kurihara, M. Daido, S. Fujita, N. Nakamura, M. Igarashi, Y. Iijima, K. Naoe, T. Kiss, and M. Iwakuma

イットリウム(Y)系超電導線材は20K以上の高温で高い磁場中臨界電流を有することから、従来の 超電導材料では必要となる高価な液体ヘリウムが不要であり、MRI(Magnetic Resonance Imaging)等 のコイル用途での応用が期待されている。今回コイル応用時に大きな問題となる遮蔽電流の抑制を目的 とし、マルチフィラメント型イットリウム系超電導線材の開発を行った。その概要を報告する。

With high critical current in magnetic field at a high temperature of above 20 K, Yttrium (Y)-based coated conductors are expected to apply to superconducting coils such as MRI (Magnetic Resonance Imaging). This is because expensive liquid helium which is required for conventional superconductors becomes unnecessary for Ybased coated conductors. To decrease screening current which becomes serious for superconducting coil, we developed multi-filamentary Y-based coated conductors. Here we report the overview.

1. まえがき

1. 1 イットリウム(Y)系超電導線材について

超電導とはある温度以下で物質の電気抵抗がゼロにな る現象である. 超電導を示す材料のうち,酸化物超電導 体は液体窒素温度(77 K = - 196 ℃)でも超電導特性を 示すものがあり,従来の金属系超電導材料よりも臨界温 度が飛躍的に高い. このことから,高温超電導と呼ばれ 幅広い応用が期待されている.

酸化物超電導の中でも当社で製造しているイットリウム系超電導線材はテープ状の構造となっており、金属基板テープの上に中間層、超電導層、保護層、安定化層が 積層されている (図 1). このうち中間層には以下の機能がある.

・超電導層の結晶配向性を向上させる

・超電導層と金属基板の反応を抑える

· ーイルコ IX的初九印

イットリウム系超電導線材において十分な特性を得る には、下地となる中間層(IBAD-MgO層, CeO₂層)の結 晶配向性が高いことが求められる.また、イットリウム 系超電導材料はハステロイと反応しやすいため、中間層 (特にCeO₂層)を挟むことでハステロイと接触させない ようにしている.

1.2 イットリウム系超電導線材の

マルチフィラメント化

イットリウム系超電導線材は 20 K以上の高い温度領域 で臨界電流密度が高いことから,特に強磁場コイルへの 応用が期待されている.しかし,コイル応用においては 大きな問題がある.一般的に,変動する磁場中に導体が 存在すると導体には磁場の変動を抑制するように渦電流 が流れるが,通常この渦電流は導体の電気抵抗によって



図1 イットリウム系超電導線材の構造 Fig. 1. The structure of Y-based coated conductors.

¹ 国立大学法人九州大学 超電導システム科学研究センター 応用物性部門 教授

² 国立大学法人九州大学 超電導システム科学研究センター 機器工学部門 教授

³ 超電導事業推進室製造部4 超電導事業推進室副室長

ニーマーティーに三町三
エネルギー技術研究部

⁶ エネルギー技術研究部次長(博士(工学))

⁷ エネルギー技術研究部部長

略語・専門用語リスト 略語・専門用語	正式表記	説 明
臨界温度	Critical temperature, T_c	超電導状態を維持できる上限の温度
臨界電流	Critical current, I_c	超電導状態で流しうる最大の電流値. 温度, 磁場に依存する.
イットリウム 系超電導線材	Y-based coated conductor	超電導層にイットリウム(Y)やガドリウム(Gd)など希土類系元素を 含む酸化物超電導線材で、希土類系を総称してRE(Rare Earth、レア アース)系とも呼ぶ.他の高温超電導に比べて30K以上の比較的高い温 度の磁場中の臨界電流(/ _c)が高い特徴がある. またRE(Rare Earth、希土類元素)-Ba(パリウム)-Cu(銅)-O(酸 素)で構成されることから、この超電導材料を総称してREBCOとも呼 ぶ.
IBAD法	イオンビームアシスト法 lon Beam Assisted Deposition	フジクラが独自に開発したイットリウム系超電導線材を作製するキーと なる技術で、超電導特性を左右する結晶配向性を金属テープ上にて高度 に制御する手法.金属テープと超電導層の間の中間層の作製に適用され、 1991年に日米欧で基本特許をフジクラが取得.高特性のイットリウム 系超電導線材の多くにこのIBAD法が用いられている.
遮蔽電流	Screening current	超電導体には外部磁場を内部に侵入させないようにする性質(マイスナー 効果)があり、外部磁場を遮蔽する磁場を作り出す.この磁場を作り出 すのが遮蔽電流であり,超電導体であるため減衰することなく流れ続け る.
磁束クリープ		磁束線がピン止め点に捕まった状態は準安定状態であり,真の平衡状態 に向けての緩和が起こる.この時の磁束線の運動を磁束クリープ(フラッ クスクリープ)といい,熱揺動に起因する.
マルチフィラ メント化		遮蔽電流を抑制するために,超電導線材を複数の細い導体(フィラメン ト)に分割すること.
EBSD法	電子線後方散乱回折法 Electron Back Scatter Diffraction	結晶性材料に電子線を照射すると、試料表面で生じる電子線広報散乱回 折により菊池線回折パターンすなわちEBSDパターンが観測され、試料 の結晶方位に関する情報が得られる、走査電子顕微鏡(SEM: Scanning Electron Microscope)と組み合わせて、電子線を走査しな がらEBSDパターンを測定、解析することで、微小領域の結晶方位の分 布に関する情報が得られる.
交流損失	AC loss	交流電流または交流磁場の印加によって超電導体中で発生するエネル ギー損失. 超電導体中にピン止めされた磁束が動くことによって発生す る. 損失分のエネルギーは熱になるため冷却効率の低下などの問題を引 き起こす.
ヒステリシス 損失		周期変化を繰り返す磁場(交番磁場)の中に試料を置いた際に,1周期 中において超電導体の磁化が変動することにより発生するエネルギー損 失
カップリング 損失		超電導体のフィラメント間に流れる常電導電流により発生するジュール 損失.フィラメント間の絶縁性を高めることが対策としては重要である.
スタッド・プル 剥離試験		積層構造を持つサンプルの表面に円柱状のピンを接着してピンの引張試 験を行い, 膜の剥離力を評価する試験方法. イットリウム系超電導線材 の場合, 超電導層にクラック等の欠陥があると剥離力が低下しやすい.

すぐに減衰する.しかし,超電導体の場合は電気抵抗が ゼロのため,この渦電流が減衰せず磁場を遮蔽し続ける. この超電導体に流れる渦電流を遮蔽電流と呼ぶ(図 2).

超電導体は電気抵抗がゼロであるが、臨界電流値に近 づくと磁束クリープと呼ばれる現象により微小なエネル ギー損失が発生する. 遮蔽電流の電流密度はおおむね超 電導体の臨界電流に等しいため、磁束クリープにより緩 やかに減衰する. このため遮蔽電流がつくる遮蔽磁場に よって,(1) ヒステリシス損失と呼ばれる磁気エネルギー のロスが発生する,(2) コイルの磁場が時間的に変動す る,(3) コイルの磁場分布が歪むなどの問題が生じてしま う¹⁾. コイル応用の中でもMRIやNMRといった機器は, 非常に精密で時間的にも安定した磁場が必要であり,遮 蔽電流は致命的な問題である. 超電導線材に流れる遮蔽 電流は超電導体の断面積を小さくすることで減少できる ため、テープ状の線材であれば線材幅を小さくすればよ い. このように線材を複数の細い導体に分割することを マルチフィラメント化という. このような理由から、従 来の金属系超電導線材では 1 本の線材の中に極細のフィ



Fig. 2. The screening current in the superconducting layer.

ラメントが多数埋め込まれた構造となっている.しかし ながらY系超電導線材は図1のようにテープ状であり, 単一の超電導層からなるモノフィラメント構造であるた め,遮蔽電流の影響が顕著である.そのため、Y系超電導 線材のマルチフィラメント化が強く望まれている.

マルチフィラメント化の方法としては,超電導層が成 膜された線材に対し長手方向に加工する方法が現在の主 流である.加工にはレーザー²⁾ や機械加工³⁾ によるスリ ットを用いる方法が報告されている.しかしながら,脆 いセラミック材料であるイットリウム系超電導材料を直 接加工するため,クラック等の欠陥を生じさせ機械特性 の低下を引き起こすおそれがある.このため,イットリ ウム系超電導線材のマルチフィラメント化においては機 械特性が大きな課題となる.今回,我々は機械強度を低 下させずにイットリウム系超電導線材をマルチフィラメ ント化する方法を開発した.以下に概要を報告する.

2. マルチフィラメント型線材の作製方法

従来のマルチフィラメント化方法での機械強度の低下 が超電導層を作製した後に加工を施すため生じることに 着目し,超電導層成膜前に加工する方法を検討した.前 述の通り超電導特性が中間層の結晶配向性に依存するこ とに着目し、中間層の結晶配向性を乱す手法を採用した. 当社の線材構造(図 1)で説明すると、①MgO成膜後に 線材長手方向に溝加工を行いMgO層がない部分を形成す る、②この線材にCeO2を成膜することで溝部の上に結 晶配向性の乱れた CeO_2 層ができる,③さらにGdBCOを 成膜することで十分に高い臨界電流密度(J_c)を持つ $GdBCO層の間に J_c \sim 0 となる GdBCO層が形成される,$ というプロセスで構成される. 同様な手法は既に報告さ れているが4), 文献 4)の手法は中間層全体を加工してい るのに対し、我々は中間層成膜工程の途中に溝加工を行 った.これは中間層の機能で説明した通り、加工によっ てハステロイが露出しても中間層(CeO2層)によって超 電導層との反応を抑制させるためである. 文献 4) の手 法は超電導層に欠陥が入ることが指摘されているが⁵⁾,加 工方法を改良することで欠陥発生リスクの低減を図った. 一方で、超電導層を直接加工しないためレーザーや機械 加工による方法に比ベマルチフィラメント化されにくい ことが予想される.従って、特性の評価においてはマル チフィラメント性の確認が重要になる.

マルチフィラメント型イットリウム系 超電導線材の作製

作製したマルチフィラメント型超電導線材の構造を図 3 に示す.水分からの保護と機械的特性の向上を目的に, Cu 安定化層としてフォーミング構造と呼ばれる Cu 箔で線材 を包む構造を採用した⁶. Cu安定化層の内部は,図 1 で 示した通り,/ハステロイ/Al₂O₃/Y₂O₃/MgO/CeO₂/ GdBCO/銀/という積層構造になっている.

次に,中間層(CeO₂層)の配向を乱すための加工について述べる.MgO層成膜後(CeO₂ 成膜前)の線材に金属の針を押し当てながら搬送させて加工を行った.加工は10 m/minで行い,4 mm幅線材において1 mm幅のフィラメントが4 本となるように長手方向に溝を3 本入れた(図 4).

以上によりフォーミング構造の 4 mm幅マルチフィラ メント型線材 113.2 mを作製した.

4. 作製した線材の評価結果

作製したマルチフィラメント型超電導線材について電 磁気的特性及び機械特性の評価を行った.その結果について述べる.

4.1 通電/。評価

まず,作製したマルチフィラメント型線材の液体窒素 中(77.3 K)での*I*。を測定した.線材を搬送させながら 4.7 mごとに 4 端子法で連続的に通電測定を行った.こ の測定結果を図 5 に示す.

同等なGdBCO層(1.9 μm)を有する従来の線材と比 較すると、どちらの線材も平均*I*_cは200 A程度であり 同程度の*I*_cが得られた.しかしながら、マルチフィラメ ント型線材(a)の結果では*I*_cが低くなっている箇所が ある.これは、それぞれのフィラメントと電極の接触抵 抗の差により電流が特定のフィラメントに偏ったため、 線材全体の*I*_cが低く評価されたものと考えられる.よっ て、マルチフィラメント型線材に対する測定方法の改良 は必要だが、溝加工そのものは*I*_cに影響を与えないとい える.



図3 マルチフィラメント型イットリウム系超電導線材の 構造(模式図) Fig. 3. The structure of the multi-filamentary tape.







図5 連続通電*I*_c測定の結果 (a) マルチフィラメント型線材 (b) 従来の線材





図6 CeO_2 層のEBSDパターン Fig. 6. The electron back scatter diffraction (EBSD) pattern of CeO_2 layer.

4. 2 EBSD法による中間層の結晶配向性評価

 溝加工による結晶配向を乱す効果を確認するために, 成膜したCeO₂層の結晶配向性をElectron Back Scatter Diffraction (EBSD, 電子線後方散乱回折)法により調べ た. EBSD法を用いることでX線回折よりもミクロに結晶 配向性を評価することができる.

図 6 に作製した線材のEBSDパターンを示す. 図 6 において,赤色は(001)方向,すなわち基板に対して垂 直に正しく結晶配向していることを表す. 一方,他の色 は(001)方向に結晶配向していないことを表しており, この領域では結晶配向したREBCO層は得られない. よっ て,目的通りMgO層に溝加工をした領域のみ結晶配向を 乱すことができた.

4.3 RTR-SHPM法による応答磁場の測定

マルチフィラメント化できているか確認するために, 超電導層をRTR-SHPM(Reel-to-reel scanning Hall-probe microscopy) 法で 2 次元的に評価した⁷⁾. この方法に は、以下の特徴がある.

- 超電導層に垂直な方向に磁場を加え、線材の応答磁 場をホール素子を用いて2次元的に測定する。
- ② 超電導性を示さない場合遮蔽電流が流れず応答磁場 は低くなる.結果として、超電導性を示す領域と示 さない領域を区別でき、マルチフィラメント化され ているかわかる.
- 3 線材を巻き取りながら(Reel-to-reel)行うことで、 線材全長について 2 次元的測定ができる.

なお, 測定は 77.3 K (液体窒素中) で行った.

図 6 に測定結果を示す. 長手方向に沿って 3 本の黒 い線が入る像が得られた. この黒い線は応答磁場の値が 低い領域であり, 遮蔽電流がほとんど流れていないこと を示している. 以上より, 今回の超電導層を直接加工し ない手法でも全長にわたってマルチフィラメント化でき ていることが確認できた.

4. 4 交流損失測定

超電導線材に交流電流または交流磁場を印可するとエ ネルギーの損失が発生する.これを交流損失と呼ぶ.交 流損失の要因としては複数あるが,先に述べた遮蔽電流 磁場によるヒステリシス損失とフィラメント間の導通に よって発生する常電導磁場に起因するカップリング損失



図7 RTR-SHPM法による応答磁場測定結果 Fig. 7. The result of measured magnetic field by RTR-SHPM method.



図8 交流損失の測定方法 Fig. 8. The measurement method of AC loss.



Fig. 9. The hysteresis curve.



図10 交流損失測定結果 Fig. 10. The result of the AC loss measurement.

が主である.特にヒステリシス損失の影響が大きいため, 交流損失はフィラメントの数に反比例して減少する⁵⁾.し たがって,交流損失を測定することでマルチフィラメン ト化による遮蔽電流削減効果を知ることができる.

今回用いたピックアップコイル法による交流損失の測 定について述べる.図8のように超電導層に垂直な方向 に外部磁場Bを加えて測定を行う.この外部磁場B=B₀ sin *ωt* と周期変化する正弦波として印可し外部磁場Bと 線材の磁化Mをプロットすると,図9のようなヒステリ シス曲線が得られる.このヒステリシス曲線に囲まれた 領域の面積が交流損失となる.外部磁場の値を変化さ せながら繰り返すことで,外部磁場の振幅B₀と交流損失 Q(磁場1周期及び単位体積当たり)の関係が得られる. なお,測定方法についてはJISで規格されている(規格番 号:JISH 7310).

図 10 に交流損失測定の結果を示す. コイル応用のタ ーゲットとなる強磁場 (>10⁻¹ T)の領域において、マ ルチフィラメント型線材の交流損失は従来の線材に比べ て約 1/3 になる結果を得た. 4 分割にも関わらず 1/4 にならなかったのは、フィラメント間の導通がある構造 によりカップリング損失が発生したためと考えられる. カップリング損失の影響はあるが、ヒステリシス損失の 抑制により確かに交流損失は抑制できていることがわか った.

4.5 剥離試験による機械特性評価

これまでマルチフィラメント型線材の電磁気的特性に ついて述べてきた.一方,コイル応用を考えると大きな 電磁力が加わるため機械特性も重要な問題となる.加工 により特性を低下させていないことを確認するべく,ス タッド・プル剥離試験により評価を行った.

今回は線材幅方向中央に φ2.7 mmのピンを Ag 層の上 に立て、スタッド・プル剥離試験の試料を作製した. 機 械的スリットの条件を変えることで、図 10 のように 3 種類の 4 mm幅線材のサンプルを 3 種類用意した(う ち 2 種類がマルチフィラメント型線材である). 試料B と試料Cは 4 等分となるように加工を行い作製した.

剥離試験の結果をワイブルプロットしたものを図 11



図11 剥離試験試料の構造 Fig. 11. The structures of delamination test samples.



図12 剥離試験結果(ワイブルプロット) Fig. 12. The result of the delamination test (Weibull plot).

に示す. 試料Bは他よりも明らかに剥離力が弱くなった. これは加工により超電導層が劣化したためと考えられる. 一方, 試料Aに対し試料Cは剥離力の低下が見られなかった.よって,我々の加工方法は剥離力に対し有効である.以上より,中間層の溝加工によるマルチフィラメン ト化は十分な機械特性を提供できると言える.

5. む す び

イットリウム系超電導線材のコイル応用のうちMRIの ように強く精密な磁場が要求される場合には,遮蔽電流 を削減するためにマルチフィラメント化する必要がある. しかしながら,従来の手法では超電導層を直接加工する ため,超電導層を劣化させ機械的特性の低下につながる おそれがある.そこで超電導層を直接加工するのではな く,中間層に溝加工を行うことでマルチフィラメント化 できないか検討した.今回我々は結晶配向性の乱れた中 間層上に成膜されたGdBCO層の臨界電流密度J_cがほぼ 0 になるという性質を用いて線材を作製した.

作製した線材について特性を評価したところ,大きな*I*。 低下や機械特性の低下を起こすことなく簡単な方法でマ ルチフィラメント化できることがわかった.この結果, コイル特性に大きな影響を持つヒステリシス損失が抑制 され、従来の線材よりもコイル応用に適した 100 m級マ ルチフィラメント型イットリウム系超電導線材を開発す ることができた.

今後はコイル化した場合のデータを集め、マルチフィ ラメント化の効果について検証を進める予定である.長 尺化を進め、最終的に量産品としてラインナップを目指 している.

参考文献

- 柳澤:「超電導マグネット開発のこれまでとこれから (その7)」,超電導Web21,2013年1月号,pp.27-31,2013
- T. Machi, et al. : "Reliable Fabrication Process for Long-Length Multi-filamentary Coated Conductors by a Laser Scribing Method for Reduction of AC Loss," Vol.26, No.10m, Superconductor Science and Technology, 2013.
- 3) 金ほか: "R&D toward a High-field & High-homogeneity NMR/MRI Developments over 1 GHz (1) Development of the REBCO Multi-core Tapes," 低温工学・超電導学 会, 2014年秋, 1A-p06, 2014
- G. Majkic, et al. : "AC Loss Filamentization of 2G HTS Tapes by Buffer Stack Removal," Vol.21, No.3, IEEE trans. Appl. Supercond., pp.3297-3300, 2011
- 5) 町ほか:「希土類系高温超電導テープ線材のスクライビング技術の動向」,低温工学 第50巻,第10号,pp.476-482,2015
- Y. Iijima, et al.: "Development for Mass Production of Homogeneous RE123 Coated Conductors by Hot-Wall PLD Process on IBAD Template Technique," IEEE trans. Appl. Supercond., Vol.25, No.3, 2015
- K. Higashikawa, et al.: "Nondestructive Diagnostics of Narrow Coated Conductors for Electric Power Applications," Vol.24, No.3, IEEE trans. Appl. Supercond., 2014